

a 2007 0334

Invenția se referă la domeniul obținerii peliculelor de oxizi de metal, în particular de In_2O_3 , cu dimensiuni mari ale suprafeței atomice plate a cristalitelor.

Procedeul de obținere a peliculelor subțiri de semiconductoare oxidice include depunerea peliculelor prin piroliză spray la temperatura de 450...550°C din soluții apoase de InCl_3 cu concentrația sării de metal din soluție ce depășește 0,2M cu recoacerea ulterioară în atmosferă neutră sau cu conținut de oxigen la o temperatură ce depășește 1000°C.

Revendicări: 2

Figuri: 3